大学物理 College Physics

主讲 华中科技大学 刘超飞

● 电子自旋

每个电子的自旋角动量Ls是量子化的

$$L_S = \sqrt{s(s+1)}\hbar$$
 $s = \frac{1}{2}$ —自旋量子数

其在空间取向也是量子化的, 且在空间某方向的投影只能取两个值:

$$L_{SZ} = m_S \hbar$$
 $m_S = \pm \frac{1}{2}$ —自旋磁量子数自旋是内秉角动量!

● 原子的壳层结构

主壳层: n = 1, 2, 3, 4, 5 ... (表示为K, L, M, N, O, P, ...)

支壳层: *l* = 0, 1, 2, 3, 4, 5,... (表示为*s*, *p*, *d*, *f*, *g*, *h*,...)

- 核外电子排布
 - 1 泡利不相容原理

原子中的任何两个电子 不可能有完全相同的一组量子数 (n, l, m_l, m_s) 。

主壳层n上可容纳的电子数为:
$$N_n = \sum_{l=0}^{n-1} 2 \ 2l + 1 = 2n^2$$

2 能量最小原理

每个电子趋向占据未被填充的最低能级.

能级的高低由n+0.71判定。

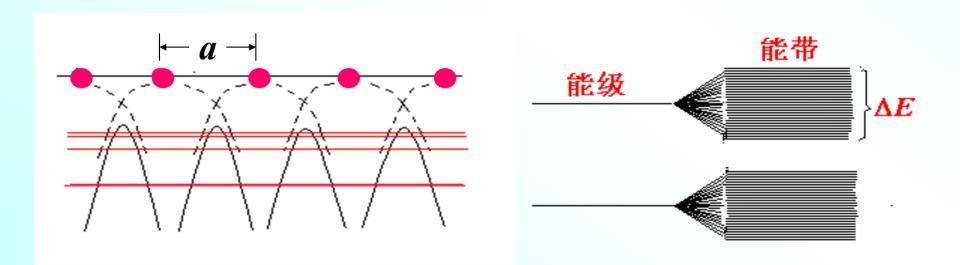
(徐光宪—经验公式)

● 固体的能带

在晶体中,电子受到周期性势场的作用。

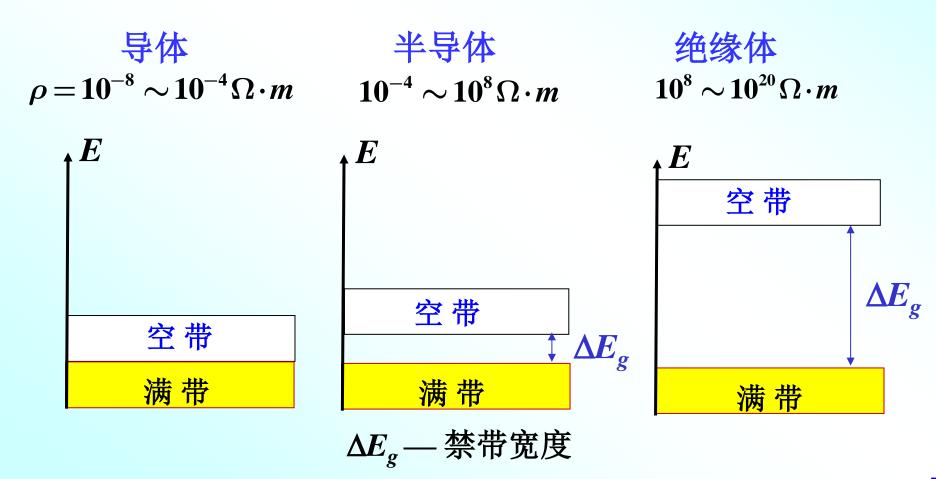
外层电子: 其势垒宽度较小,穿透概率较大,成为共有化电子。

由于各原子间的相互作用,对应于原来孤立原子的每一个能级,变成了N条靠得很近的能级,称为能带。



2. 导体、半导体和绝缘体的能级结构

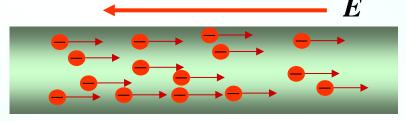
按导电性能的高低固体可以分为三类 它们的导电性能不同,是因为它们的能带结构不同。



何为导电?

●从现象来看:

在外电场的作用下,大量电子集体 定向移动形成电流。





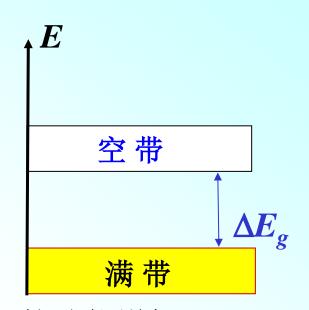
与加外电场前相比,这些定向移动的电子的动能增加了。也就是说,这些电子的(总)能量增加了。

能量要增加,电子必须从低能级跃迁到高能级上去。

●从能带的观点来看:

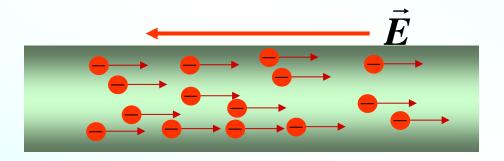
导带上的电子的能量(整体上)可以增加,所以可以导电;

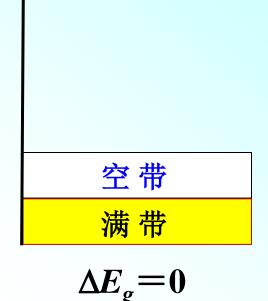
而由于泡利不相容原理的限制,满带上的电子在满带中 只能交换位置。这不能引起它们整体的能量状态的改变。 故,满带上的电子不能导电。



导体:满带与空带之间没有禁带。

在外电场的作用下,大量电子很易获得能量,集体定向流动形成电流。





从能级图上来看,是因为其共有化电子很容易从低能级跃迁到高能级上去。

绝缘体:满带与空带之间有一个较宽的禁带

 $(\Delta E_g 约3~6~\text{eV})$ 。

共有化电子很难从低能级(满带)跃迁到高能级导带(空带或价带)上去。

在外电场的作用下,共有化电子很难吸收外电场的能量,所以不能形成电流

空 带
ΔEg

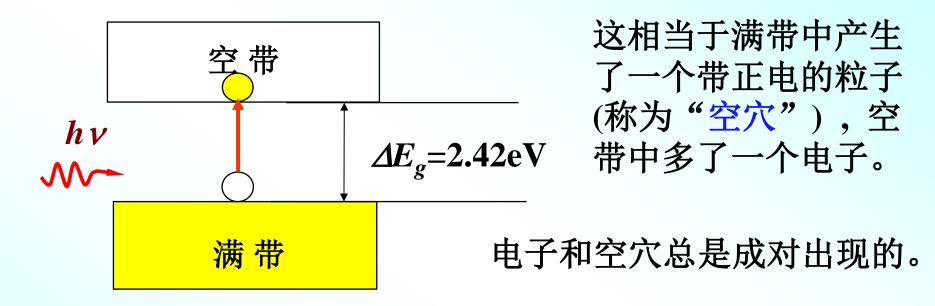
半导体:满带与空带之间是禁带。但是禁带很窄 $(\Delta E_{\varrho}$ 约0.1~2~eV

满带中的电子较易进入导带。

导带中的电子在外场作用下可向稍高能级转移,参与导电。



例: 半导体 CdS (硫化镉)



用硫化镉(CdS)制成的光敏电阻,在没有受光照射时,它的暗电阻可达几十兆欧,当受光照后,其阻值则骤降到几千欧,仅为原阻值的几百分之一。不仅如此,还可以产生电动势,这是半导体的光电效应。

利用该特性可制成光敏电阻和光电池,前者在自动控制系统中得到广泛应用,后者在空间技术和人类利用太阳能方面得到应用。

3. 半导体的导电机构

a. 本征半导体 是指纯净的半导体。

其导电性能在导体与绝缘体之间。

满带上的一个电子有可能跃迁到空带,于是满带中出现一个空位,即产生一个空穴。

在外场的作用下,导带中的电子、满带中的空穴都可参与导电。(本征导电性)

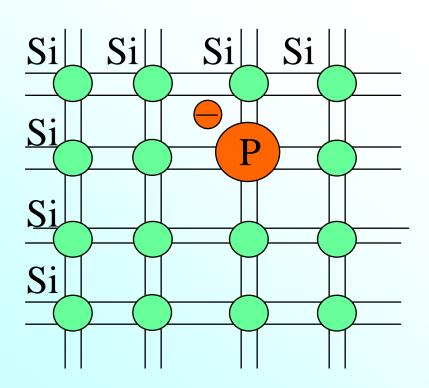
两个概念:

- 1. 电子导电……半导体的载流子是电子
- 2. 空穴导电……半导体的载流子是空穴

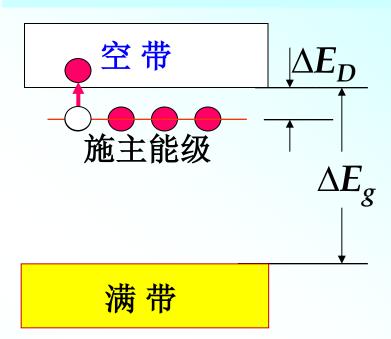
b. 杂质半导体

(1) n型半导体

四价的本征半导体 Si、Ge等, 掺入少量五价的杂质元素(如P、 As等)形成电子型半导体,称 n 型半导体。



量子力学指出,这种掺杂后多余的电子其能级在禁带中紧靠空带处, $\Delta E_D \sim 10^{-2} \text{eV}$,极易形成电子导电。

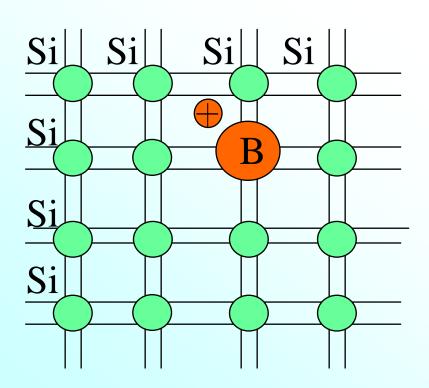


在n型半导体中 电子.....多数载流子 空穴.....少数载流子

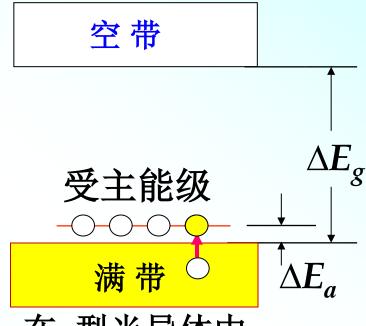
b. 杂质半导体

(2) p型半导体

四价的本征半导体 Si、Ge等, 掺入少量三价的杂质元素(如B、 Ga、In等)形成空穴型半导体, 称 p 型半导体。



量子力学指出,这种掺杂后多余的空穴其能级在禁带中紧靠满带处, $\Delta E_a \sim 10^{-2} \mathrm{eV}$,极易形成电子导电。



在*p*型半导体中空穴.....多数载流子电子.....少数载流子

二. 激光

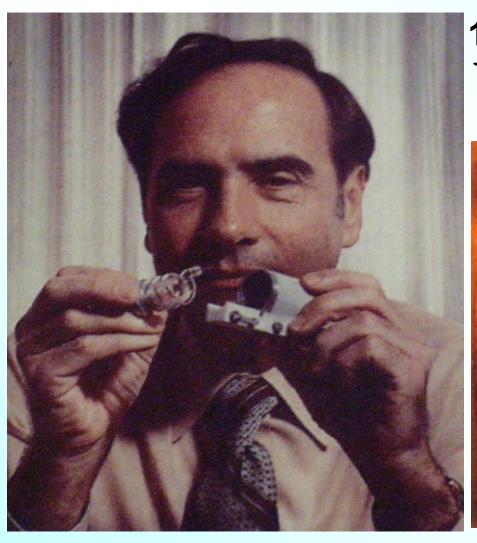
激光是二十世纪六十年代出现的一种新型光源(激光器)发出的光。

1960年美国休斯研究实验室的梅曼制成了第一台 红宝石激光器。1961年9月中国科学院长春光学 精密机械研究所制成了我国第一台激光器。

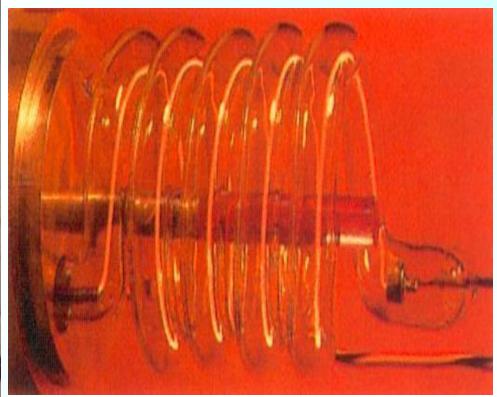
激光 (Laser)全名是"辐射的受激发射所致的光放大" (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)

LASER

1964年10月,钱学森建议称之为激光。

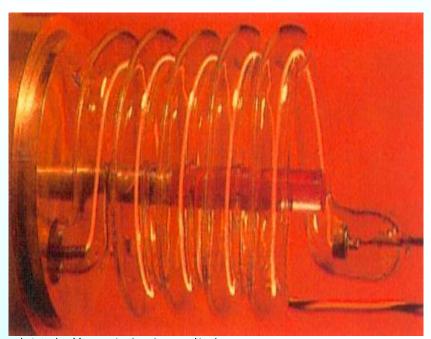


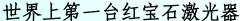
1960年梅曼(T. H. Maiman)发明了世界上第一台红宝石激光器



T. H. Maiman

我国第一台红宝石激光器(1961.9)







在器件设计上,梅曼用螺旋管氙灯照射,我国科学家用光学成像的办法,只用了一支较小的直管氙灯,其尺寸同红宝石棒的大小差不多,用高反射的球形聚光器聚光,使红宝石棒好象泡在光源(氙灯)的像中,所以效率很高,用很小的能量就可获得激光。

激光的种类:

按工作物质分

固体激光器(如红宝石Al₂O₃)

气体激光器(如He-Ne, CO,)

有机染料激光器

半导体激光器(如砷化镓 GaAs)

光纤激光器

自由电子激光器

远红外、红外激光器 按工作波段分可见光激光器 紫外、真空紫外激光器 X光激光器

按工作方式分 脉冲激光器

连续激光器 超短脉冲激光器



激光的特点:

相干性极好(相干长度可达几十甚至上百公里)

方向性极好(发散角~10-4弧度)

脉冲瞬时功率大(可达~10 15瓦以上)

亮度极高(巨型脉冲固体激光器的亮度可比太阳亮度高100亿倍

- ---精密测量,全息摄影......
- ---准直、测距、制导......
- ---切削、武器、手术刀
- ---激光光纤通讯.....
- ---激光惯性约束核聚变......
- ---激光推进

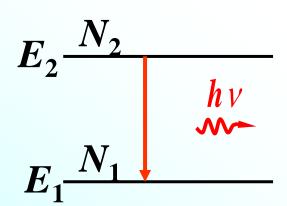
• • • • •



激光的原理:

1. 原子的跃迁(自发辐射、受激辐射和受激吸收)

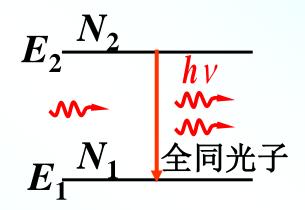
a. 自发辐射



各原子自发辐射的 光是相互独立的非 相干光。

普通光源发光

b. 受激辐射



受激辐射光与外来光的 频率、偏振方向、相位 及传播方向均相同 -----有光的放大作用。



获得激光的途径

c.受激吸收

$$E_2 \frac{N_2}{h_1}$$
 $E_1 \frac{N_2}{N_1}$

上述外来光也有可能被吸收,使 原子从 $E_1 \rightarrow E_2$ 在光与物质的相互作用中,三种跃迁同时存在。

受激辐射和受激吸收是等几率的。

受激辐射和受激吸收中哪个占优势取决于原子数 N_2 和 N_1 。

 $N_2 < N_1$,吸收跃迁占优势,表现为光的吸收; $N_2 > N_1$,受激辐射占优势,可获得激光。

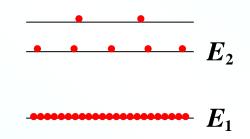
$$E_2$$
 N_2

正常情况下,由大量原子组成的系统,在温度不太低的平衡态,原子数目按能级的分布服从 玻耳兹曼统计分布:

$$N_n \propto e^{-rac{E_n}{kT}}$$

因为 $E_2 > E_1$,则两能级上的原子数目之比:

$$\frac{N_2}{N_1} = e^{-\frac{E_2 - E_1}{kT}} < 1$$
 (正常分布)



$$E_2 > E_1$$
,则两能级上的原子数目之比: $\frac{N_2}{N_1} = e^{-\frac{E_2 - E_1}{kT}} < 1$ (正常分布)

估计原子数目之比:

以氢原子为例:
$$E_n = \frac{-13.6 eV}{n^2}$$
 $T \sim 300 \text{K}$
 $kT = 1.38 \times 10^{-23} \times 300 \approx 0.026 \text{ eV}$

$$E_2 \frac{N_2}{E_1}$$

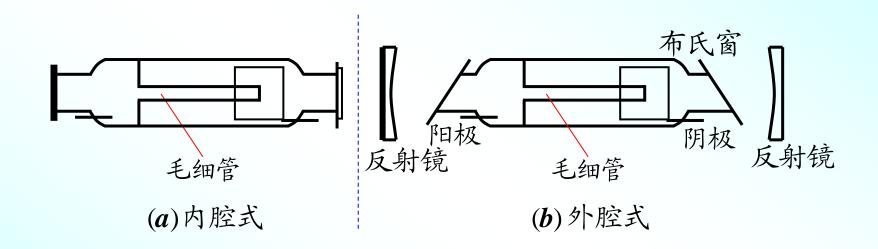
$$\Rightarrow \frac{N_2}{N_1} = e^{-\frac{E_2 - E_1}{kT}} = e^{-\frac{10.2}{0.026}} \approx \frac{1}{10^{171}} \ll 1$$
$$\frac{N_3}{N_2} \approx \frac{1}{10^{32}} \ll 1$$

但要产生激光必须使 $N_2 >> N_1$

这称为粒子数反转 (因为正常分布是 $N_2 << N_1$) 如何实现粒子数反转?

2. He-Ne激光器的工作原理

(1962年在美国贝尔实验室研制成功)



在He-Ne激光器中,

He是辅助物质,Ne是激活物质,

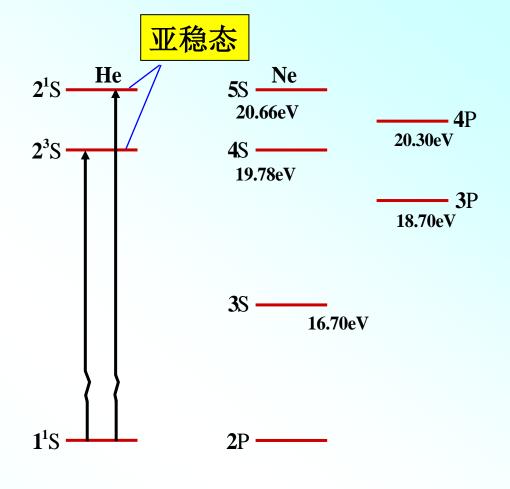
He与 Ne之比为5:1~10:1。

He原子和Ne原子的能级:

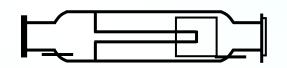
由于电子的碰撞, He原子被激发到2³S和2¹S能级的概率比Ne 原子被激发到高能级的概率大。

He的2³S和2¹S能级都是 亚稳态,很难回到基态。

原子在亚稳态上的寿命 (10⁻³s~1s)比在一般高 能级上(10⁻⁸s)长得多。



因此,在He的这两个亚稳态上集聚了 较多的He原子。



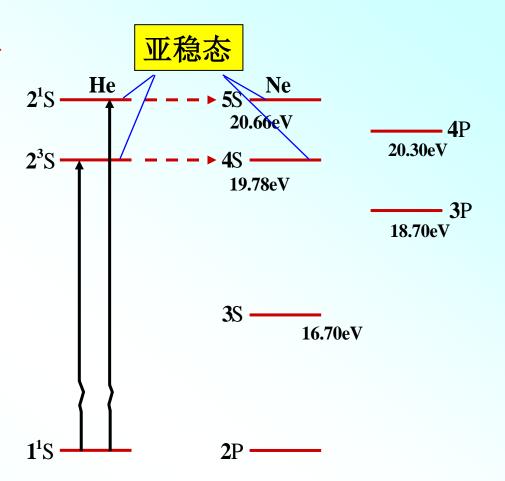
在He的两个亚稳态上集聚了 较多的He原子。

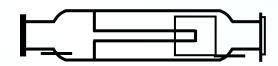
Ne的5S 和4S与He的2¹S和2³S的能量几乎相等,

当两种原子相碰时非常容易产生能量的"共振转移"。

在碰撞中He原子把能量传递给Ne原子而回到基态,而Ne原子则被激发到5S或4S:

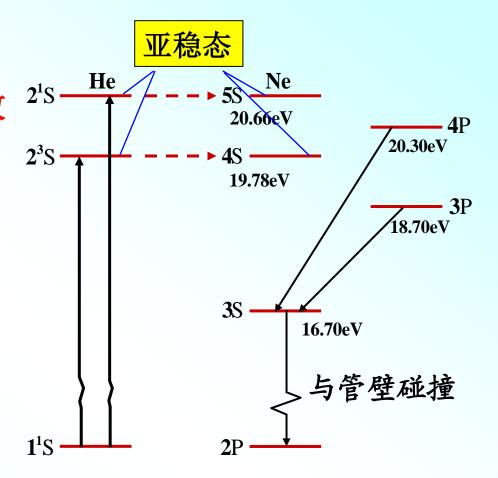
而Ne的5S、4S也是亚稳态,下能级4P、3P的寿命比上能级5S、4S要短得多,这样就可以实现粒子数反转。



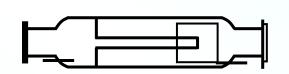


Ne的5S对4P、3P形成粒子数反转,4S对3P形成粒子数反转。

要产生激光,除了增加上能级的粒子数外,还要设法减少下能级的粒子数,比如,减少Ne的3P和4P上的粒子数。



放电管做得较细,可使原子与管壁频繁碰撞。借助这种碰撞,3S态的Ne原子可以将能量交给管壁发生"无辐射跃迁"而回到基态,及时减少3S态的Ne原子数,有利于激光下能级4P与3P态的抽空。



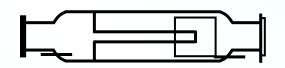
Ne的5S对4P、3P形成粒子数反转,4S对3P形成粒子数反转。

Ne原子可产生多个波长的激光谱线。

最强的三条的波长是 3.39 μm 1.15 μm 0.6328μm

亚稳态 He $.39 \mu m$ 20.66eV 2^3S **4**S 19.78eV₁ 18.70eV 16.70eV 与管壁碰撞

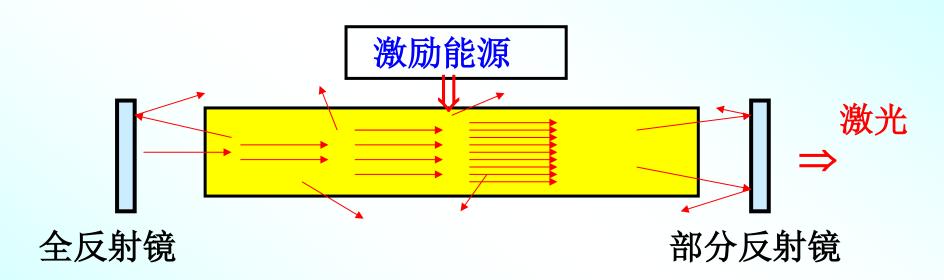
它们都是从亚稳态到非亚稳态、非基态之间发生的



如何选择波长(频率)?

3. 光学谐振腔

激光器有两个反射镜,它们构成一个光学谐振腔。



光学谐振腔的作用:

- 1. 使激光具有极好的单色性(选频)。
- 2. 使激光具有极好的方向性(选向);
- 3. 增强光放大作用(放大);

光学谐振腔两端的反射镜处必定是波节,

所以光程满足驻波条件:
$$nL = k \frac{\lambda_k}{2}$$
 $(k=1, 2, 3,)$ n —谐振腔内媒质的折射率 λ_k —真空中的波长

$$\lambda_k = \frac{2nL}{k}$$

$$k=2$$

$$k=3$$

小结:产生激光的必要条件

1) 粒子数反转

为保证实现粒子数反转必须: 「有激励能源(使原子激发) 有激活物质(有合适的能级结构)

2) 光学谐振腔(选频,选向,光放大)

作业: 16—T1-T4

作业要求

- 1. 独立完成作业。
- 2. 图和公式要有必要的标注或文字说明。
- 3. 作业纸上每次都要写姓名以及学号(或学号末两位)。
- 4. 课代表收作业后按学号排序,并装入透明文件袋。
- 5. 每周二交上周的作业。迟交不改。
- 6. 作业缺交三分之一及以上者综合成绩按零分计。